

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成17年9月2日(2005.9.2)

【公開番号】特開2000-332098(P2000-332098A)
【公開日】平成12年11月30日(2000.11.30)
【出願番号】特願平11-136656
【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/76

【F I】

H 0 1 L 21/76 L

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月2日(2005.3.2)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0003
【補正方法】変更
【補正の内容】

【0003】

例えば、特開平7-326659号公報には、アスペクト比が1より大きな溝形アイソレーション形成用の深溝を半導体基板に形成した後、この深溝内にアスペクト比が1以内の浅溝が残るように第1の埋込絶縁膜を埋め込み、続いて半導体基板上に第2の埋込絶縁膜を堆積した後、浅溝内に埋め込まれた第2の埋込絶縁膜の上部を、その上面位置が浅溝の周囲の平面位置と等しくなるように平坦化する方法(第1の方法)が開示されている。